

- H01L 23/12** → (51) **H01L 23/053**
- H01L 23/14** → (51) **H05K 1/02**
- H01L 23/29** → (51) **H01L 23/053**
- H01L 23/34** → (51) **H01L 23/053**
- (51) **H01L 23/48** (11) **1 721 335 A2\***  
(25) En (26) En  
(21) 05713952.9 (22) 23.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- AL BA HR LV MK YU  
(86) US 2005/005641 23.02.2005  
(87) WO 2005/091868 2005/40 06.10.2005  
(30) 05.03.2004 US 792757  
(54) • **CHIP-HANDHABUNG AUF WAFER-MASS-STAB**  
• **WAFER SCALE DIE HANDLING**  
• **MANIPULATION DE MICROPLAQUETTES AU NIVEAU DE LA TRANCHE**
- (71) Ziptronix, Inc., 800 Perimeter Park Drive, Suite B, Morrisville, NC 27560, US  
(72) ENQUIST, Paul, M., Cary, NC 27513, US  
FOUNTAIN, Gaius, G., Jr., Youngsville, NC 27596, US  
PETTEWAY, Carl, T., Raleigh, NC 27615, US  
(74) Poulin, Gérard, BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris, FR
- H01L 23/48** → (51) **H01L 31/0256**
- H01L 27/08** → (51) **H01F 17/00**
- (51) **H01L 27/108** (11) **1 721 336 A2\***  
**G11C 11/22** **G11C 11/34**  
(25) En (26) En  
(21) 05722842.1 (22) 10.02.2005  
(84) DE FR GB IT  
(86) US 2005/004030 10.02.2005  
(87) WO 2005/081798 2005/36 09.09.2005  
(88) 24.11.2005  
(30) 23.02.2004 US 785160  
(54) • **DOPPEL-EEPROM-SPEICHERTRANSISTOREN MIT ABGESTUFTEN UNTEROBERFLÄCHEN-FLOATING-GATES**  
• **TWIN EEPROM MEMORY TRANSISTORS WITH SUBSURFACE STEPPED FLOATING GATES**  
• **TRANSISTORS MEMOIRE EEPROM DOUBLE AVEC GRILLES FLOTTANTES EN GRADINS SOUS LA SURFACE**
- (71) ATMEL CORPORATION, 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, US  
(72) LOJEK, Bohumil, Colorado Springs, CO 80906, US  
(74) Käck, Jürgen, Kahler Käck Molekopt Vorderer Anger 239, 86899 Landsberg/Lech, DE
- H01L 29/00** → (51) **H01L 31/0256**
- (51) **H01L 29/768** (11) **1 721 337 A1\***  
(25) Fr (26) Fr  
(21) 05716754.6 (22) 21.02.2005  
(84) DE FR GB IT NL  
(86) EP 2005/050740 21.02.2005  
(87) WO 2005/096388 2005/41 13.10.2005  
(30) 02.03.2004 FR 0402148  
(54) • **INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT EINER SEHR KLEINEN LESEDIODE**  
• **INTEGRATED CIRCUIT WITH A VERY SMALL-SIZED READING DIODE**  
• **CIRCUIT INTEGRE AVEC DIODE DE LECTURE DE TRES PETITES DIMENSIONS**

- (71) Atmel Grenoble S.A., Avenue de Rochepleine, B.P. 123, 38521 Saint-Egrève Cedex, FR  
(72) BLANCHARD, Pierre, THALES, F-94117 Arcueil, FR  
(74) Guérin, Michel, et al, Marks & Clerk France 31-33 Avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cédex, FR
- (51) **H01L 31/0256** (11) **1 721 338 A2\***  
**H01L 29/00** **H01L 31/0312**  
**H01L 23/48**  
(25) En (26) En  
(21) 05723572.3 (22) 22.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- AL BA HR LV MK YU  
(86) US 2005/005749 22.02.2005  
(87) WO 2005/081976 2005/36 09.09.2005  
(88) 24.08.2006  
(30) 20.02.2004 US 784903  
(54) • **REPROGRAMMIERBARER METALL-ZU-METALL-ANTIFUSE MIT KOHLENSTOFFHALTIGEM ANTIFUSEMATERIAL**  
• **REPROGRAMMABLE METAL-TO-METAL ANTIFUSE EMPLOYING CARBON-CONTAINING ANTIFUSE MATERIAL**  
• **ANTIFUSIBLE METAL-METAL REPROGRAMMABLE ET ANTIFUSIBLE AVEC MATERIAU CONTENANT DU CARBONE**
- (71) ACTEL CORPORATION, 2061 Slierlin Court, Mountain View, California 94043-4635, US  
(72) ISSAQ, A., Farid, Campbell, CA 95008, US  
HAWLEY, Frank, Campbell, CA 95008, US  
MCCOLLUM, John, Saratoga, CA 95070, US  
(74) Leeming, John Gerard, J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn, London WC1R 5JJ, GB
- H01L 31/0312** → (51) **H01L 31/0256**
- H01L 31/032** → (51) **H01L 31/04**
- (51) **H01L 31/04** (11) **1 721 339 A1\***  
**H01L 31/032**  
(25) En (26) En  
(21) 05722187.1 (22) 04.03.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- (86) SE 2005/000333 04.03.2005  
(87) WO 2005/086238 2005/37 15.09.2005  
(30) 05.03.2004 SE 0400582  
(54) • **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR IN-LINE-PROZESSSTEUERUNG DES CIGS-PROZESSES**  
• **METHOD AND APPARATUS FOR IN-LINE PROCESS CONTROL OF THE CIGS PROCESS**  
• **PROCEDE ET APPAREIL DE COMMANDE DE PROCESSUS EN LIGNE DU PROCES-SUS CIGS**
- (71) Solibro AB, Ultuna, 756 51 Uppsala, SE  
(72) STOLT, Lars, S-755 91 Uppsala, SE  
KESSLER, John, F-44000 Nantes, FR  
(74) Svanfeldt, Hans-Ake, DR. LUDWIG BRANN PATENTBYRA AB P.O. Box 17192, 104 62 Stockholm, SE
- (51) **H01L 33/00** (11) **1 721 340 A1\***  
**H01L 21/00**  
(25) En (26) En  
(21) 05706648.2 (22) 23.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- (86) CN 2005/000212 23.02.2005  
(87) WO 2005/081327 2005/35 01.09.2005

- (30) 23.02.2004 CN 200410004550  
(54) • **LICHTEMISSIONSBAUELEMENT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR**  
• **LIGHT EMITTING DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF**  
• **DISPOSITIF LUMINESCENT ET PROCEDE DE FABRICATION**
- (71) Hong-Yuan Technology Co., Ltd., 3 Fl., No. 1, Alley 16 Lane 305, Zhonghe Road, Yonghe City, Taipei County, Taiwan 234, TW  
(72) WU, Yu-Chao, Taiwan 234, CN  
CHENG, Wei-Yuan, Taipei County Taiwan 241, CN  
(74) Blasberg, Tilo, 2K Patentanwälte Kewitz & Kollegen Partnerschaft Corneliusstrasse 18, D-60325 Frankfurt am Main, DE
- (51) **H01L 33/00** (11) **1 721 341 A1\***  
(25) En (26) En  
(21) 05726372.5 (22) 05.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- (86) KR 2005/000360 05.02.2005  
(87) WO 2005/076374 2005/33 18.08.2005  
(30) 05.02.2004 KR 2004007541  
(54) • **III-NITRIDVERBINDUNGS-HALBLEITER-LICHTEMISSIONSBAUELEMENT**  
• **III-NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE**  
• **DISPOSITIF ELECTROLUMINESCENT SEMI-CONDUCTEUR A COMPOSE DE NITRURE III**
- (71) Epivalley Co., Ltd., 51-2, Neungpyeong-ri, Opo-eup, Kwangju-si, Kyunggi-do 464-892, KR  
(72) PARK, Joongseo 606-103, Samsung Raemian, Yongin-si, Kyunggi-do 449-564, KR  
(74) Müller - Hoffmann & Partner, Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17, 81667 München, DE
- (51) **H01L 33/00** (11) **1 721 342 A1\***  
(25) En (26) En  
(21) 05726438.4 (22) 05.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- (86) KR 2005/000361 05.02.2005  
(87) WO 2005/078813 2005/34 25.08.2005  
(30) 13.02.2004 KR 2004009529  
(54) • **III-NITRIDVERBINDUNGS-HALBLEITER-LICHTEMISSIONSBAUELEMENT**  
• **III-NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE**  
• **DISPOSITIF ELECTROLUMINESCENT SEMI-CONDUCTEUR A COMPOSE NITRURE III**
- (71) Epivalley Co., Ltd., 51-2, Neungpyeong-ri, Opo-eup, Kwangju-si, Kyunggi-do 464-892, KR  
(72) YOO, Tae Kyung, 115-603, Samsung Raemian Apt., Yongin-si, Kyunggi-do 449-912, KR  
PARK, Eun Hyun, Seongnam-si, Kyunggi-do 463-835, KR  
(74) Müller - Hoffmann & Partner, Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17, 81667 München, DE
- H01L 35/10** → (51) **H01L 35/32**
- (51) **H01L 35/32** (11) **1 721 343 A2\***  
**H01L 35/10**  
(25) En (26) En  
(21) 05719022.5 (22) 28.02.2005  
(84) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE  
SI SK TR
- (86) IT 2005/000112 28.02.2005  
(87) WO 2005/086246 2005/37 15.09.2005  
(88) 27.10.2005  
(30) 02.03.2004 IT MI20040079 U